

**SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED
HIGH EFFICIENCY SILICON RECTIFIER**
VOLTAGE RANGE 50 to 1000 Volts CURRENT 2.0 Amperes

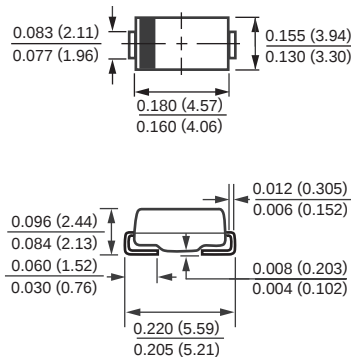
FEATURES

- * Glass passivated device
- * Ideal for surface mounted applications
- * Low leakage current
- * Metallurgically bonded construction
- * Mounting position: Any
- * Weight: 0.098 gram

MECHANICAL DATA

- * Epoxy : Device has UL flammability classification 94V-0

DO-214AA



Dimensions in inches and (millimeters)

MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Ratings at 25 °C ambient temperature unless otherwise specified.
Single phase, half wave, 60 Hz, resistive or inductive load.
For capacitive load, derate current by 20%.

MAXIMUM RATINGS (At TA = 25°C unless otherwise noted)

RATINGS	SYMBOL	HFM201	HFM202	HFM203	HFM204	HFM205	HFM206	HFM207	HFM208	UNITS
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	V _{RRM}	50	100	200	300	400	600	800	1000	Volts
Maximum RMS Volts	V _{RMS}	35	70	140	210	280	420	560	700	Volts
Maximum DC Blocking Voltage	V _{DC}	50	100	200	300	400	600	800	1000	Volts
Maximum Average Forward Current at T _A = 55°C	I _O	2.0								Amps
Peak Forward Surge Current 8.3 ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC method)	I _{FSM}	60								Amps
Typical Junction Capacitance (Note 2)	C _J	30					20			pF
Operating and Storage Temperature Range	T _J , T _{STG}	-55 to + 150								°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (At TA = 25°C unless otherwise noted)

CHARACTERISTICS		SYMBOL	HFM201	HFM202	HFM203	HFM204	HFM205	HFM206	HFM207	HFM208	UNITS
Maximum Forward Voltage at 2.0A DC		V _F	1.0			1.3		1.7			Volts
Maximum Full Load Reverse Current, Full cycle Average T _A =55°C		I _R	50								uAmps
Maximum DC Reverse Current at	@ T _A = 25°C		5.0								uAmps
Rated DC Blocking Voltage	@ T _A = 125°C		100								uAmps
Maximum Reverse Recovery Time (Note 1)		t _{rr}	50					75			nSec

NOTES : 1. Test Conditions: IF=0.5A, IR=-1.0A, IRR=-0.25A.

2. Measured at 1 MHz and applied reverse voltage of 4.0 volts.

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (HFM201 THRU HFM208)

FIG. 1 - TEST CIRCUIT DIAGRAM AND REVERSE RECOVERY TIME CHARACTERISTIC

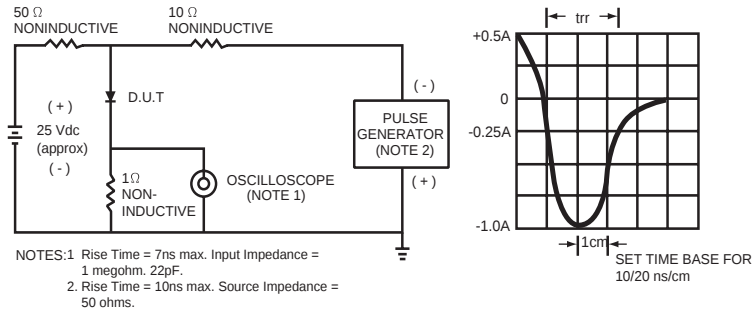


FIG. 2 - TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE

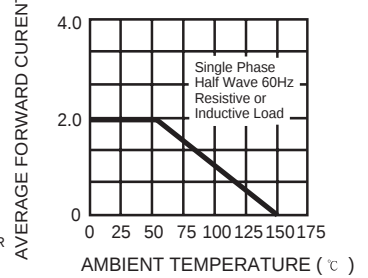


FIG. 3 - TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS

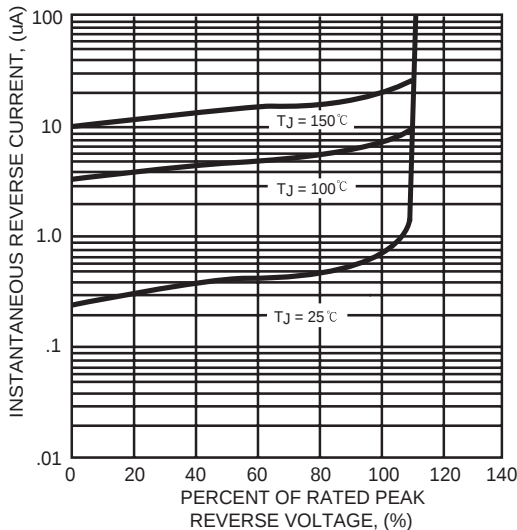


FIG. 4 - TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD CHARACTERISTICS

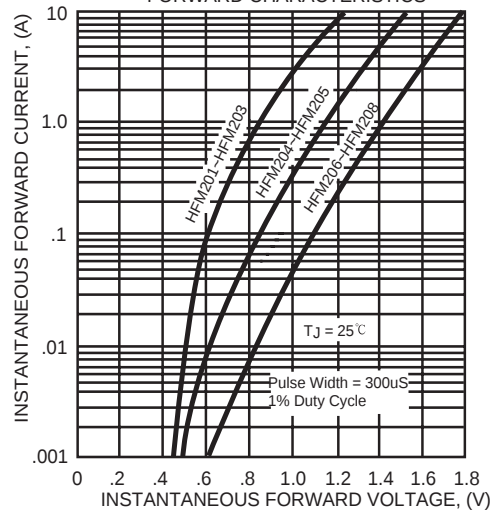


FIG. 5 - MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD SURGE CURRENT

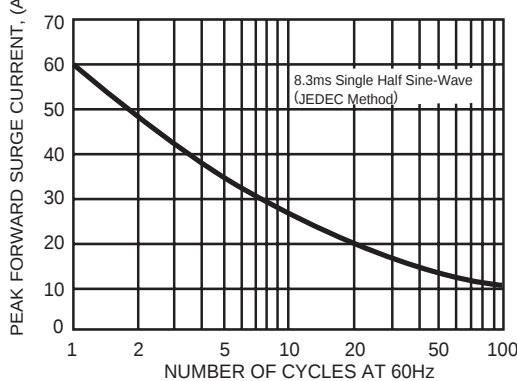
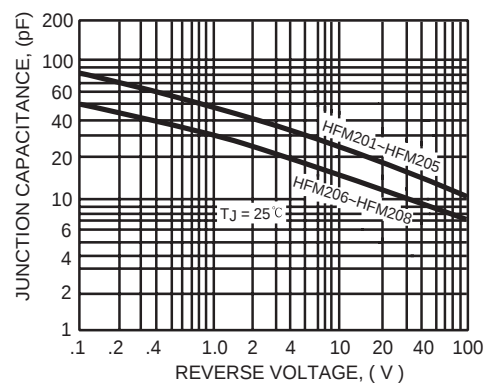
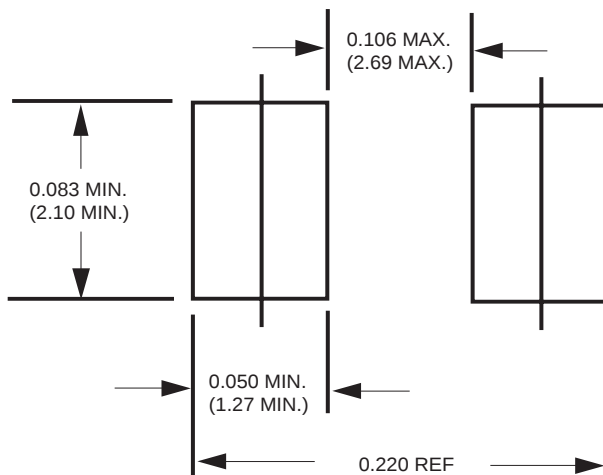


FIG. 6 - TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE



Mounting Pad Layout



Dimensions in inches and (millimeters)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9